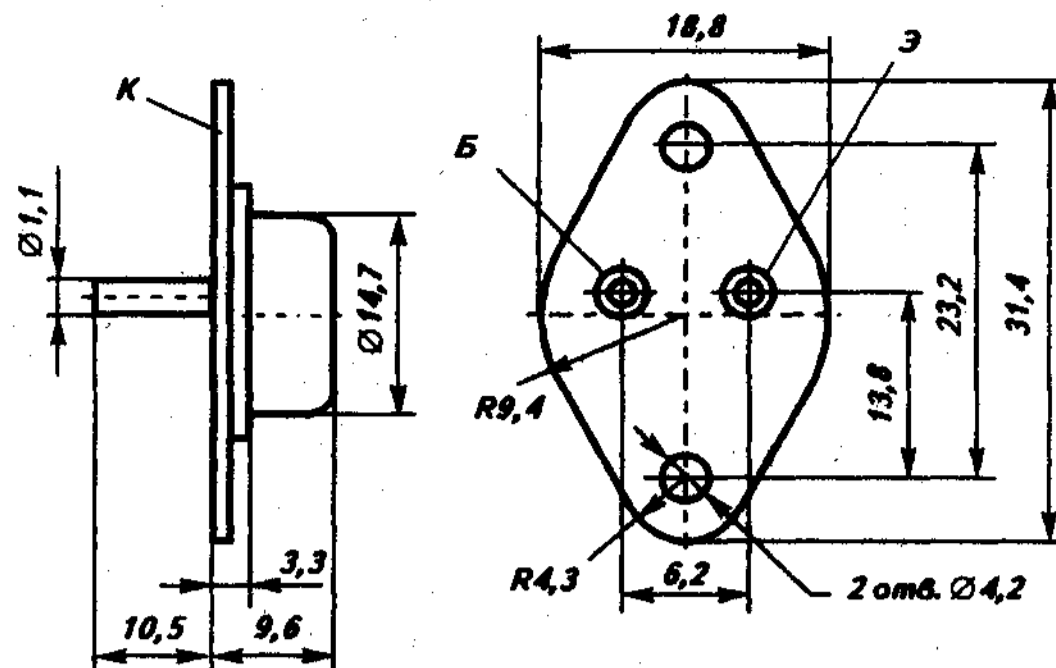


□ 2Т716А, 2Т716Б, 2Т716В

Транзисторы кремниевые меза-планарные структуры *n-p-n* составные универсальные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в металлическом корпусе с жесткими выводами и стеклянными изоляторами. Масса транзистора не более 20 г.



2Т716А, 2Т716Б, 2Т716В

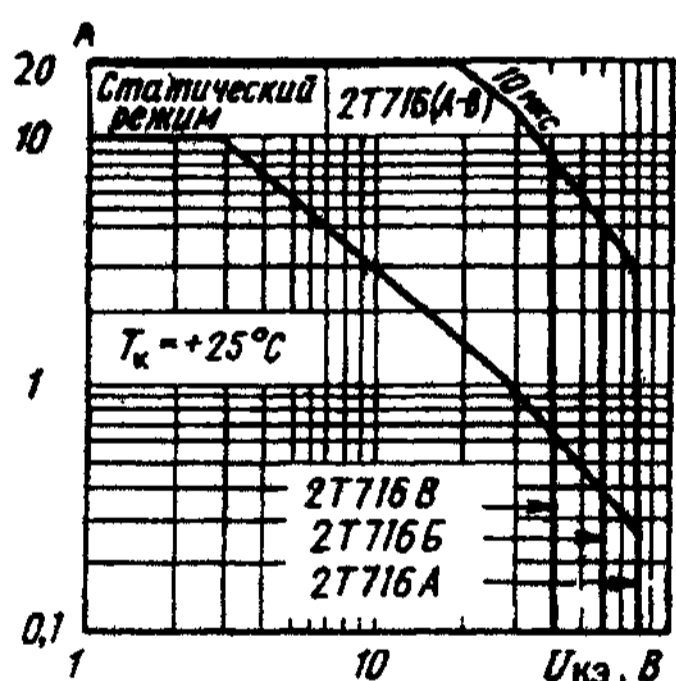
Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5 В$, $I_э = 5 А$, не менее	750
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $U_{кэ} = 5 В$, $I_к = 0,5 А$, $f = 3 МГц$, не менее	2
Граничное напряжение при $I_э = 100 мА$, не менее:	
2Т716А	80 В
2Т716Б	60 В
2Т716В	40 В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_к = 5 А$, $I_б = 0,02 А$, не более	2 В
Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_к = 5 А$, $I_б = 0,02 А$, не более	3 В
Пробивное напряжение коллектор-база при $I_к = 1 мА$, не менее:	
2Т716А	100 В
2Т716Б	80 В
2Т716В	60 В
Пробивное напряжение база-эмиттер при $I_э = 5 мА$, не менее	5 В
Время включения при $U_{кэ} = 20 В$, $I_к = 5 А$, $I_б = 0,02 А$, не более	2 мкс
Время выключения при $U_{кэ} = 20 В$, $I_к = 5 А$, $I_б = 0,02 А$, не более	7 мкс
Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 5 В$, не более	150 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0,5 В$, не более	350 пФ

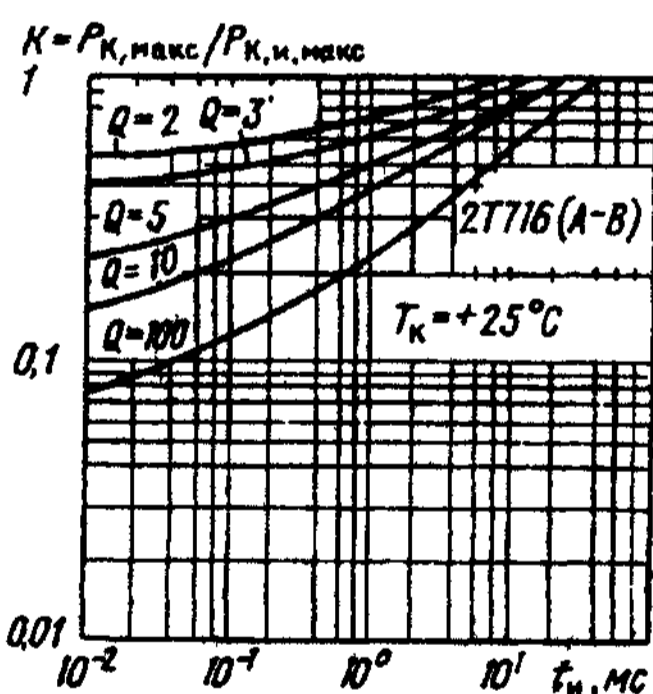
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-база:	
2Т716А	100 В
2Т716Б	80 В
2Т716В	60 В
Постоянное напряжение коллектор-эмиттер:	
при $R_{эб} = 1 кОм$:	
2Т716А	100 А
2Т716Б	80 В
2Т716В	60 В
при $R_{эб} = ∞$:	
2Т716А	80 А
2Т716Б	60 В
2Т716В	40 В
Постоянное напряжение база-эмиттер	5 В
Постоянный ток коллектора	10 А
Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 2 мс$	20 А
Постоянный ток базы	0,2 А
Импульсный ток базы при $t_{и} = 2 мс$	0,3 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора ¹ при $T_к = -60...+25^{\circ}C$:	
с теплоотводом	30 Вт
без теплоотвода	2 Вт
Температура окружающей среды	$-60^{\circ}C... T_к = 125^{\circ}C$

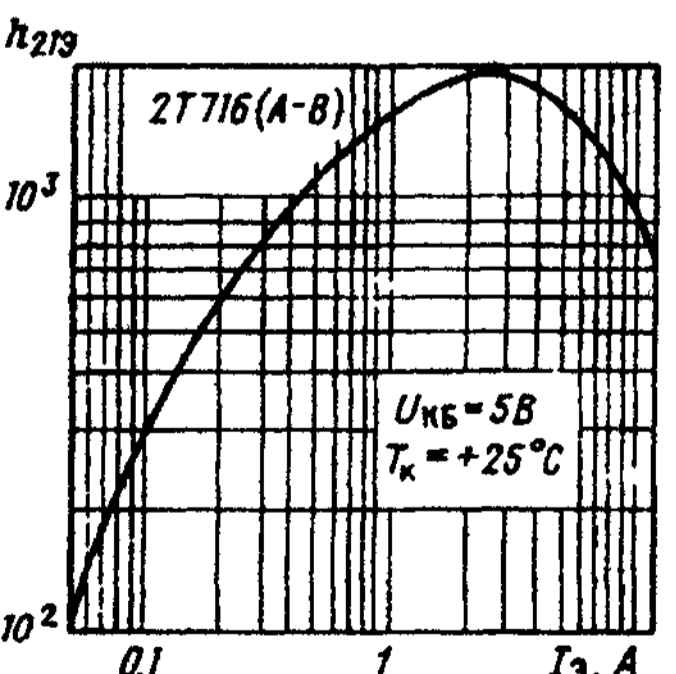
¹ При $T_к = +25^{\circ}C$ $P_{к, макс}$ снижается линейно на $0,24 Вт/^{\circ}C$ с теплоотводом и на $16 мВт/^{\circ}C$ без теплоотвода



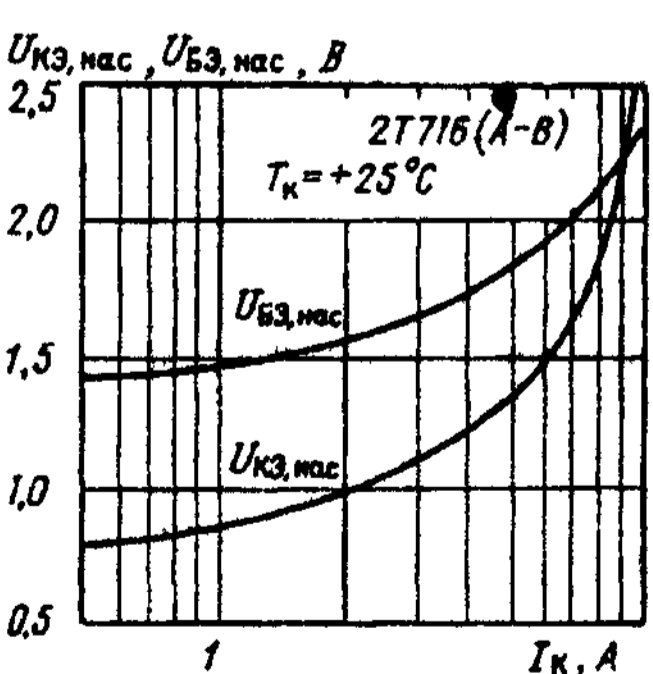
Области безопасной работы транзисторов



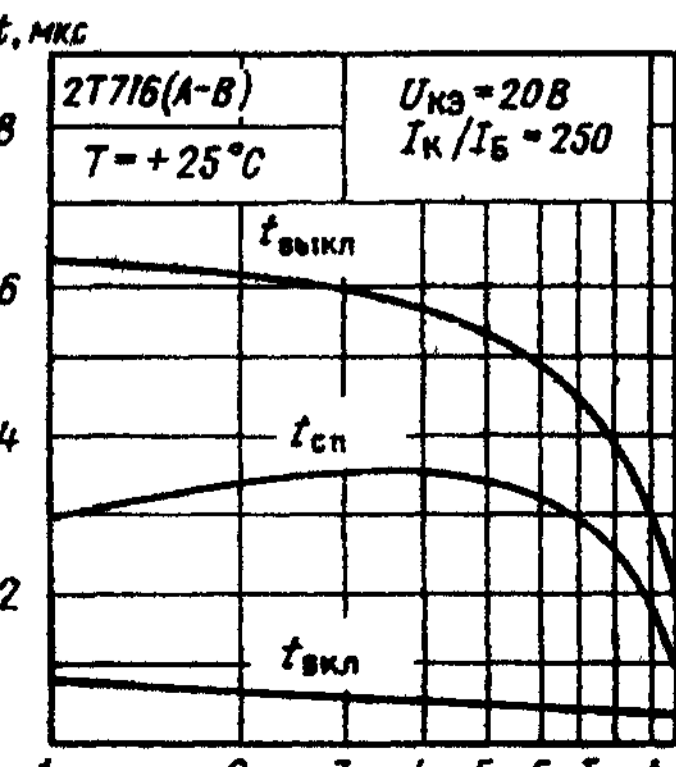
Зависимости коэффициента К от длительности импульса



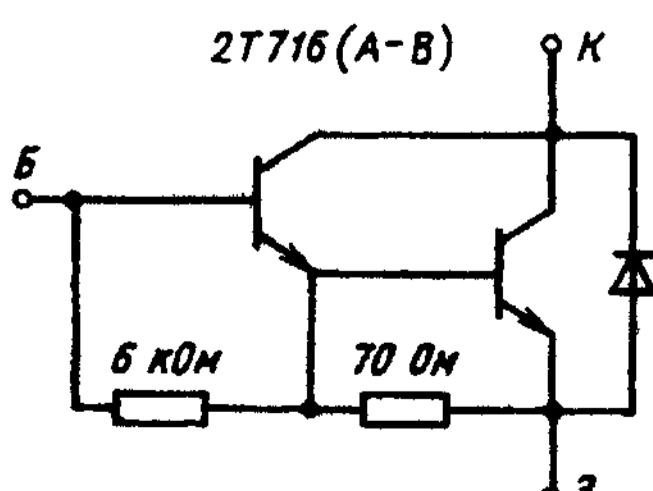
Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимости напряжений насыщения коллектор-эмиттер и база-эмиттер от тока коллектора



Зависимости времени включения, выключения и спада от тока коллектора



Принципиальная схема транзистора